Market News

EasyDUAL™ CoolSiC™ MOSFET-Leistungsmodule mit neuem Keramik-Substrat ermöglichen höhere Leistungsdichte und kompaktere Designs

München – 29. April 2021 – Ein neues Leistungsmodul mit Keramik-Substrat aus Aluminiumnitrid (AIN) ergänzt die EasyDUAL™ CoolSiC™ MOSFET-Familie der Infineon Technologies AG. Die Bauteile sind erhältlich als Halbbrücken-Konfiguration mit einem Durchlasswiderstand ($R_{DS(on)}$) von 11 mΩ in einem EasyDUAL 1B-Gehäuse sowie mit 6 mΩ in einem EasyDUAL 2B-Gehäuse. Durch die verbesserten Eigenschaften der Hochleistungskeramik eignen sich die 1200-V-Module für Anwendungen mit hoher Leistungsdichte wie Solaranlagen, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Hilfsbetriebeumrichter sowie Energiespeichersysteme und Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Die EasyDUAL-Module FF11MR12W1M1_B70 und FF6MR12W2M1_B70 sind mit der neuesten CoolSiC-MOSFET-Technologie ausgestattet, die eine hervorragende Gate-Oxid-Zuverlässigkeit aufweist. Durch die verbesserte Wärmeleitfähigkeit des DCB-Materials lässt sich der Wärmwiderstand zum Kühlkörper (R_{thJH}) um bis zu 40 Prozent reduzieren. In Kombination mit den CoolSiC-Easy-Modulen verbessert die neue AlN-Keramik entweder die Ausgangsleistung oder senkt die Sperrschichttemperaturen. Damit kann eine verbesserte Lebensdauer des Systems erreicht werden.

Verfügbarkeit

Die EasyDUAL CoolSiC MOSFET-Module FF11MR12W1M1_B70 und FF6MR12W2M1_B70 sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/easy. Das EasyDUAL wird auf der Virtual Power Conference von Infineon gezeigt, die die „PCIM Europe digital days“ begleitet.

Virtual Power Conference 2021 von Infineon

Experience the difference in Power – Der Schlüssel zu einer energieeffizienten Welt sind Leistungshalbleiter. Neue Technologien wie Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) erhöhen die Leistungseffizienz und ermöglichen kleinere Formfaktoren bei gleichzeitig geringerem Gewicht. Nach wie vor spielt aber auch Silizium eine große Rolle bei den Designs. Energieeffizienz ist Schwerpunkt der

Für die Fachpresse
Informationsnummer INFIPC202104.062d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Fabian Schiffer
Tel.: +49 89 234-25869
fabian.schiffer@infineon.com

Investor Relations:
Tel.: +49 89 234-26655
investor.relations@infineon.com

„Virtual Power Conference“ von Infineon vom 4. bis 6. Mai 2021. Als führender Anbieter von Leistungshalbleitern präsentiert das Unternehmen auf der exklusiven digitalen Plattform Technologien und Methoden, um Energie effizienter zu erzeugen, sie mit geringeren Verlusten zu übertragen und zu verteilen und sie in einem breiten Anwendungsspektrum effizienter zu nutzen. Industrie, Transport & eMobility und Verbraucher stellen dabei die Themenschwerpunkte dar. Die Online-Plattform öffnet ihre Türen am 4. Mai 2021. Zur Registrierung bitte hier klicken.

Für die Fachpresse
Informationsnummer INFIPC2021XX.0XXd

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Fabian Schiffer
Tel.: +49 89 234-25869
fabian.schiffer@infineon.com

Investor Relations:

Tel.: +49 89 234-26655
investor.relations@infineon.com